01

# Экранирование низкочастотных электрических полей системой экранов: тонкая незамкнутая эллипсоидная оболочка-тонкостенный проницаемый цилиндр

© С.М. Аполлонский,<sup>1</sup> В.Т. Ерофеенко,<sup>2</sup> Г.Ч. Шушкевич<sup>3</sup>

 <sup>1</sup> Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности, 194021 Санкт-Петербург, Россия
 <sup>2</sup> Белорусский государственный университет, 220050 Минск, Белоруссия
 <sup>3</sup> Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, 230023 Гродно, Белоруссия e-mail: appolo@promt.spb.su

#### (Поступило в Редакцию 17 декабря 2002 г.)

Решена задача о проникновении низкочастотного электрического поля через тонкостенный бесконечный проводящий цилиндр, на оси которого находится идеально тонкая незамкнутая эллипсоидная проводящая оболочка, методом парных уравнений с использованием соответствующих теорем сложения и усредненных граничных условий. Численно исследовано влияние угла раствора незамкнутой эллипсоидальной оболочки на коэффициент ослабления поля внутри этой оболочки для некоторых геометрических параметров экранов.

С практической и теоретической точек зрения важным классом задач электродинамики являются задачи экранирования электромагнитных полей (ЭМП). В случае тонкостенных экранов не проводят исследование электромагнитных процессов в слое экрана, а связывают ЭМП по обе стороны проводящего экрана с помощью эквивалентных граничных условий, заданных на срединной поверхности экрана [1-3]. Такой подход строго обоснован, если толщина экрана не превышает глубину проникновения ЭМП. В данной работе исследуется проникновение низкочастотного электрического поля через тонкостенную цилиндрическую проводящую оболочку в присутствии тонкой незамкнутой эллипсоидальной идеально проводящей оболочки. Полученные результаты могут быть использованы при конструировании экранирующих систем.

#### Постановка задачи экранирования

Пусть в однородном изотропном пространстве  $R^3$  с диэлектрической проницаемостью  $\varepsilon_0$  находится тонкостенный бесконечный цилиндр Г толщины  $\Delta$ . На оси цилиндра расположена идеально тонкая незамкнутая вытянутая эллипсоидальная идеально проводящая оболочка *S*, расположенная на вытянутом эллипсоиде вращения *S*<sub>1</sub> (см. рисунок). Среда, заполняющая тонкостенный цилиндр Г, характеризуется диэлектрической проницаемостью  $\varepsilon$ , магнитной проницаемостью  $\mu$  и электрической проводимостью  $\gamma$ . На окружности радиуса l > d равномерно распределен электрический заряд *q*, колеблющийся по закону  $q \cos \omega t$ , где  $\omega$  — круговая частота.

Для решения задачи свяжем с точкой O цилиндрические { $\rho, \varphi, z$ } и вырожденные эллипсоидные { $\alpha, \beta, \varphi$ } координаты. Оболочка *S* в системе координат  $\{\alpha, \beta, \phi\}$  описывается следующим образом:

$$S = \Big\{ \alpha = \alpha_0 = \operatorname{Arch} \frac{b}{c}, \ 0 \le \beta \le \beta_0 < \pi, \ 0 \le \varphi \le 2\pi \Big\},$$

где  $c = \sqrt{b^2 - a^2}$  — половина межфокусного расстояния, *b* и *a* — большая и малая полуоси эллипсоида соответственно.

Далее условно разобьем все пространство  $R^3$  поверхностью эллипсоида  $S_1$  и срединной поверхностью  $\tilde{\Gamma}$  тонкостенного цилиндра  $\Gamma$  радиуса d на три области:  $D_1$  — область, расположенная внутри эллипсоида  $S_1$ ,  $D_3$  — область вне цилиндра  $\tilde{\Gamma}$ ,  $D_2 = R^3 \setminus (\bar{D}_1 \cup \bar{D}_2)$ .



Ставится задача о рассеянии первичного поля на системе экранов  $\Gamma$  и *S* с учетом проникновения поля через цилиндрический слой  $\Gamma$ , при этом предполагается непроницаемость оболочки *S* для поля.

Обозначим через  $U_d$  потенциал первичного поля,  $U_j$  — потенциал вторичного поля в области  $D_j$ , j = 1, 2, 3. В квазистационарном приближении решение задачи сводится к нахождению электрических потенциалов  $U_j$  в областях  $D_j$ , j = 1, 2, 3, удовлетворяющих: уравнению Лапласа  $\Delta U_i = 0$ ;

граничным условиям на срединной поверхности  $\tilde{\Gamma}$  [4, с. 86], описывающим проникновение поля через тонкостенный цилиндрический слой  $\Gamma$ ,

$$\frac{\partial}{\partial \rho} \left( U_3 + U_d - U_2 \right) \Big|_{\tilde{\Gamma}} = -pF(U_3 + U_d + U_2) \Big|_{\tilde{\Gamma}}, \quad (1)$$

$$\frac{\partial}{\partial\rho} \left( U_3 + U_d + U_2 \right) \Big|_{\tilde{\Gamma}} = qF(U_3 + U_d - U_2) \Big|_{\tilde{\Gamma}}, \qquad (2)$$

где

$$p = rac{arepsilon'\delta}{2arepsilon_0}, \quad q = rac{2}{\omega^2 \delta \mu arepsilon_0}, \quad \delta = rac{2}{k} \operatorname{tg}\left(rac{k\Delta}{2}
ight),$$
  
 $k = \omega \sqrt{\mu arepsilon'}, \quad 0 \le rg k < \pi,$   
 $arepsilon' = arepsilon + i rac{\gamma}{\omega}$ 

— комплексная диэлектрическая проницаемость;  $\omega = 2\pi f$  — круговая частота поля;  $F(U_j) =$   $= (\mathbf{n}, \operatorname{rot} [\mathbf{n} \times \operatorname{grad} U_j])$  — граничный оператор на срединной поверхности  $\tilde{\Gamma}$  цилиндрической оболочки  $\Gamma$ ;  $\mathbf{n}$  — единичная нормаль к поверхности  $\tilde{\Gamma}$ , направленная в область  $D_3$ ;

граничному условию на поверхности тонкой незамкнутой эллипсоидальной идеально проводящей оболочке *S* 

$$U_2(M)\big|_{M\in\mathcal{S}} = V - \text{const},\tag{3}$$

условию на бесконечности

$$U_j(M) \rightarrow 0$$
 при  $M \rightarrow \infty$ ;  $j = 2, 3,$  (4)

где *М* — произвольная точка области *D*<sub>*i*</sub>.

Потребуем также выполнения условия непрерывности потенциала на поверхности  $S_1$  и условия непрерывности поля на открытой части поверхности эллипсоида  $S_1 \setminus S$ 

$$U_1 = U_2, \quad \alpha = \alpha_0, \quad 0 \le \beta \le \pi,$$
 (5)

$$\frac{\partial U_1}{\partial \alpha} = \frac{\partial U_2}{\partial \alpha}, \quad \alpha = \alpha_0, \quad \beta_0 < \beta \le \pi.$$
 (6)

Граничный оператор  $F(U_j)$  в цилиндрической системе координат имеет представление [3]

$$F(U_j) = \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} U_j + \frac{\partial^2}{\partial z^2} U_j.$$
(7)

#### Представление решения задачи

Потенциал первичного поля имеет представление

$$U_d = U_0 \int_{-\infty}^{\infty} f(\lambda) \frac{I_0(\lambda \rho)}{I_0(\lambda d)} \exp(i\lambda z) dz, \qquad (8)$$

где

$$U_0 = \frac{q}{4\pi^2 \varepsilon_0}, \quad f(\lambda) = K_0(|\lambda|l)I_0(\lambda d) \exp(-i\lambda z_0),$$

*z*<sub>0</sub> — расстояние от начала координат.

Потенциалы  $U_j$  ищем в виде суперпозиции цилиндрических и эллипсоидальных гармонических функций так, чтобы выполнялось условие на бесконечности (4),

$$U_{1}(\alpha,\beta) = \frac{U_{0}}{d} \sum_{n=0}^{\infty} \tilde{y_{n}} \frac{P_{n}(\operatorname{ch}\alpha)}{P_{n}(\operatorname{ch}\alpha_{0})} P_{n}(\cos\beta) \quad \mathbf{B} \quad D_{1},$$
$$U_{2} = U_{2}^{(1)}(\alpha,\beta) + U_{2}^{(2)}(\rho,z) \quad \mathbf{B} \quad D_{2}, \tag{9}$$

где

$$U_2^{(1)}(\alpha,\beta) = \frac{U_0}{d} \sum_{n=0}^{\infty} y_n \frac{Q_n(\operatorname{ch} \alpha)}{Q_n(\operatorname{ch} \alpha_0)} P_n(\cos\beta), \qquad (10)$$

$$U_2^{(2)}(\rho, z) = U_0 \int_{-\infty}^{\infty} Z(\lambda) \frac{I_0(\lambda \rho)}{I_0(\lambda d)} \exp(i\lambda z) \, d\lambda, \qquad (11)$$

$$U_{3}(\rho, z) = U_{0} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{Z}(\lambda) \frac{K_{0}(|\lambda|\rho)}{K_{0}(|\lambda|d)} \exp(i\lambda z) d\lambda \quad \text{B} \quad D_{3}.$$
(12)

Здесь  $P_n(\cos\beta)$  — полиномы Лежандра,  $P_n(z)$  и  $Q_n(z)$  — функции Лежандра первого и второго рода соответственно,  $I_m(x)$  — модифицированная функция Бесселя первого рода,  $K_m(x)$  — модифицированная функция Бесселя второго рода (функция Макдональда) [5–8].

Неизвестные коэффициенты  $\tilde{y}_n$ ,  $y_n$  и функции  $\tilde{Z}(\lambda)$ ,  $Z(\lambda)$  подлежат определению из граничных условий.

## Выполнение граничных условий

Для выполнения граничных условий (1), (2) представим потенциал  $U_2^{(1)}(\alpha,\beta)$  через цилиндрические гармонические функции, используя соответствующие теоремы сложения [3,9]. Тогда

$$U_2^{(1)}(\rho, z) = U_0 \int_{-\infty}^{\infty} M(\lambda) K_0(|\lambda|\rho) \exp(i\lambda z) \, d\lambda, \qquad (13)$$

где

$$M(\lambda) = \frac{c}{\pi d} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{j_n(c\lambda)}{i^n Q_n(\operatorname{ch} \alpha_0)} y_n, \qquad (14)$$

 $j_n(z)$  — сферическая функция Бесселя первого рода [5,9].

Принимая во внимание представления (8), (11)–(13), представление граничного оператора  $F(U_j)$  в цилиндрической системе координат (7) и выполняя граничные условия (1), (2), получим систему вида

$$\begin{split} \left( K_{0}'(x)|\lambda| - \lambda^{2}pK_{0}(x) \right) I_{0}(x)\tilde{Z}(\lambda) \\ &- \left( I_{0}'(x)|\lambda| + \lambda^{2}pI_{0}(x) \right) K_{0}(x)Z(\lambda) \\ &= \left( K_{0}'(x)|\lambda| + \lambda^{2}pK_{0}(x) \right) I_{0}(x)K_{0}(x)M(\lambda) \\ &+ \left( \lambda^{2}pI_{0}(x) - |\lambda|I_{0}'(x) \right) K_{0}(x)f(\lambda), \\ \left( K_{0}'(x)|\lambda| + \lambda^{2}qK_{0}(x) \right) I_{0}(x)\tilde{Z}(\lambda) \\ &+ \left( I_{0}'(x)|\lambda| - \lambda^{2}qI_{0}(x) \right) K_{0}(x)Z(\lambda) \\ &= \left( -K_{0}'(x)|\lambda| + \lambda^{2}qK_{0}(x) \right) I_{0}(x)K_{0}(x)M(\lambda) \end{split}$$

$$- \left(\lambda^2 q I_0(x) + |\lambda| I_0'(x)\right) K_0(x) f(\lambda),$$

где  $x = |\lambda| d$ .

Решая данную систему получим, что

$$Z(\lambda) = Z_1(|\lambda|d)f(\lambda) + I_0(\lambda d)M(\lambda)Z_2(|\lambda|d), \qquad (15)$$

где

$$Z_{1}(|\lambda|d) = \frac{(q+p)}{d} \frac{(\lambda d)^{2}}{\Delta(|\lambda|d)},$$

$$Z_{2}(|\lambda|d) = -\frac{2}{\Delta(|\lambda|d)} \left[ (\lambda d)^{2} (K_{1}(|\lambda|d))^{2} + \frac{pq}{d^{2}} (\lambda d)^{4} (K_{0}(|\lambda|d))^{2} \right],$$

$$\Delta(|\lambda|d) = \frac{q-p}{d} \lambda d^{2} - 2(\lambda d)^{2} K_{1}(|\lambda|d) I_{1}(|\lambda|d) + 2 \frac{pq}{d^{2}} (\lambda d)^{4} K_{0}(|\lambda|d) I_{0}(|\lambda|d).$$

Для выполнения граничных условий (3), (5), (6) представим  $U_2^{(2)}(\rho, z)$  через эллипсоидальные гармонические функции, используя соответствующую теорему сложения [3,9]. Тогда

$$U_2^{(2)}(\alpha,\beta) = U_0 \sum_{n=0}^{\infty} D_n P_n(\operatorname{ch} \alpha) P_n(\cos\beta), \qquad (16)$$

где

$$D_n = i^n (2n+1) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{j_n(c\lambda)}{I_0(\lambda d)} Z(\lambda) \, d\lambda.$$
 (17)

Согласно представлениям (9), (10), (16), условие непрерывности потенциала на поверхности эллипсоида  $S_1$  в силу ортогональности полиномов Лежандра

#### Журнал технической физики, 2003, том 73, вып. 8

 $P_n(\cos\beta)$  на отрезке  $[0, \pi]$  эквивалентно условию

$$\tilde{y}_n = y_n + dD_n P_n(\operatorname{ch} \alpha_0); \quad n = 0, 1, 2, \dots$$
 (18)

Выполняя граничные условия (3), (6) и принимая во внимание представление (18) и вронскиан [7]

$$W\{P_n(\operatorname{ch} \alpha), Q_n(\operatorname{ch} \alpha)\} = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 \alpha}$$

получим парные сумматорные уравнения вида

$$\sum_{n=0}^{\infty} y_n P_n(\cos\beta) = \sum_{n=0}^{\infty} (V_0 \delta_{0n} - dD_n P_n(\cosh\alpha_0)) P_n(\cos\beta),$$
$$0 \le \beta < \beta_0,$$
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{y_n}{2} P_n(\cos\beta) = 0.$$

$$\sum_{n=0}^{y_n} \frac{y_n}{\operatorname{sh} \alpha_0 P_n(\operatorname{ch} \alpha_0) Q_n(\operatorname{ch} \alpha_0)} P_n(\cos \beta) = 0,$$
  
$$\beta_0 < \beta \le \pi, \tag{19}$$

где  $\delta_{0n}$  — символ Кронекера,  $V_0 = V_d/U_0$ .

Введем в рассмотрение новые коэффициенты  $T_n$  по формуле

$$y_n = (2n+1) \operatorname{sh} \alpha_0 P_n(\operatorname{ch} \alpha_0) Q_n(\operatorname{ch} \alpha_0) T_n \qquad (20)$$

и малый параметр

$$g_n = 1 - (2n+1) \operatorname{sh} \alpha_0 P_n(\operatorname{ch} \alpha_0) Q_n(\operatorname{ch} \alpha_0),$$
  
 $g_n = O(n^{-2})$  при  $n \to \infty.$  (21)

Тогда парные уравнения (19) преобразуются к виду

$$\sum_{n=0}^{\infty} (1 - g_n) T_n P_n(\cos\beta)$$
$$= \sum_{n=0}^{\infty} (V_0 \delta_{0n} - dD_n P_n(\operatorname{ch} \alpha_0)) P_n(\cos\beta), \quad \beta < \beta_0,$$
$$\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1) T_n P_n(\cos\beta) = 0, \quad \beta_0 < \beta.$$

Вышеприведенные парные сумматорные уравнения преобразуются к бесконечной системе линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) второго рода относительно коэффициентов  $T_n \in l_2$  [8,9]

$$T_{s} - \sum_{n=0}^{\infty} g_{n} Q_{sn} T_{n} = V_{0} Q_{s0}$$
$$- d \sum_{n=0}^{\infty} D_{n} P_{n}(\operatorname{ch} \alpha_{0}) Q_{ns}, \quad s = 0, 1, 2, \dots, \quad (22)$$

где

$$Q_{ns} = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\beta_0} \cos\left(n + \frac{1}{2}\right) x \cos\left(s + \frac{1}{2}\right) x \, dx$$

или

$$\begin{aligned} Q_{ns} &= \frac{1}{\pi} \left[ \frac{\sin(n-s)\beta_0}{(n-s)} + \frac{\sin(n+s+1)\beta_0}{(n+s+1)} \right], \\ & \frac{\sin(n-s)\beta_0}{(n-s)} \Big|_{n=s} = \beta_0. \end{aligned}$$

Из представлений (14), (20) следует, что

$$M(\lambda) = \frac{c \, \mathrm{sh} \, \alpha_0}{\pi d}$$
$$\times \sum_{k=0}^{\infty} (-i)^k (2k+1) j_k (c\lambda) P_k (\mathrm{ch} \, \alpha_0) T_k. \quad (23)$$

Используя последовательно представления (15), (17), (23) преобразуем правую часть системы (22). В результате получим бесконечную СЛАУ вида

$$T_{s} - \sum_{n=0}^{\infty} [g_{n}Q_{sn} - \alpha_{ns}]T_{n} = V_{0}Q_{s0} - f_{s};$$
  
$$s = 0, 1, 2, \dots, \qquad (24)$$

где

$$\alpha_{ns} = \frac{\operatorname{sh}\alpha_0}{\pi} (-1)^n (2n+1) P_n(\operatorname{ch}\alpha_0)$$
$$\times \sum_{p=0}^{\infty} i^{n+p} (2p+1) P_p(\operatorname{ch}\alpha_0) Q_{ps} I_{np}, \qquad (25)$$

$$I_{np} = 2\tau \int_{0}^{\infty} j_{n}(\tau t) j_{p}(\tau t) Z_{2}(t) dt,$$
  
$$\tau = \frac{c}{d}, \quad n+p - \text{ четное}, \qquad (26)$$

$$f_s = \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1) P_n(\operatorname{ch} \alpha_0) Q_{ns} J_n, \qquad (27)$$

$$J_n = 2 \int_0^\infty j_n(\tau t) Z_1(t) K_0(\sigma t) p_n(t) dt, \quad \sigma = \frac{l}{d},$$
$$\left( (-1)^{\frac{n}{2}} \cos\left(\frac{z_0}{t}t\right), \quad n - \text{ yethoe.} \right)$$

$$p_n(t) = \begin{cases} (-1)^2 \cos\left(\frac{d}{d}t\right), & n - \text{ четное,} \\ (-1)^{\frac{n+3}{2}} \sin\left(\frac{z_0}{d}t\right), & n - \text{ нечетное.} \end{cases}$$
(28)

## Вычисление коэффициента экранирования (ослабления) поля

Напряженность первичного поля в произвольной точке пространства  $M_0(\rho, z)$  в отсутствие экранов равна

$$\mathbf{E}_{d}(M_{0}) = -\left(\frac{\partial U_{d}}{\partial \rho} \mathbf{e}_{\rho} + \frac{\partial U_{d}}{\partial z} \mathbf{e}_{z}\right)$$
$$= -U_{0} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(\lambda) \frac{I_{0}'(\lambda \rho)}{I_{0}(\lambda d)} \lambda e^{i\lambda z} d\lambda \mathbf{e}_{\rho} + \int_{-\infty}^{\infty} f(\lambda) \frac{I_{0}(\lambda \rho)}{I_{0}(\lambda d)} (i\lambda) e^{i\lambda z} d\lambda \mathbf{e}_{z}\right].$$

Если точка  $M_0(\rho, z)$  находится на оси Oz, то  $\rho = 0$  и  $I_0(0) = 1$ ,  $I_1(0) = 0$ . Поэтому

$$\mathbf{E}_{d}(0, z) = -U_{0} \int_{-\infty}^{\infty} f(\lambda)(i\lambda)e^{i\lambda z} d\lambda \,\mathbf{e}_{z}$$
$$= \frac{2U_{0}}{d^{2}} \int_{0}^{\infty} K_{0}(\sigma t)I_{0}(t)t \sin\left[\frac{t(z-z_{0})}{d}\right] dt \,\mathbf{e}_{z}.$$
 (29)

Напряженность вторичного поля в произвольной точке  $M_0$  на оси  $O_z$  области  $D_2$  равна

$$\mathbf{E}_{2}(M_{0}) = \mathbf{E}_{2}^{(1)}(M_{0}) + \mathbf{E}_{2}^{(2)}(M_{0}), \qquad (30)$$

где

$$\mathbf{E}_{2}^{(2)}(M_{0}) = -\left(\frac{\partial U_{2}^{(2)}}{\partial \rho}\mathbf{e}_{\rho} + \frac{\partial U_{2}^{(2)}}{\partial z}\mathbf{e}_{z}\right)\Big|_{\rho=0}$$
$$= -U_{0}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{Z(\lambda)}{I_{0}(\lambda d)}(i\lambda)e^{i\lambda z} d\lambda \mathbf{e}_{z}.$$

Принимая во внимание представления (15), (23), после некоторых преобразований получим, что

$$\mathbf{E}_{2}^{(2)}(0,z) = -U_{0}[I_{12}(z) + I_{22}(z)] \,\mathbf{e}_{z}, \qquad (31)$$

где

$$I_{12}(z) = -\frac{2}{d^2} \int_0^\infty Z_1(t) K_0(\sigma t) t \sin\left(\frac{t(z-z_0)}{d}\right) dt,$$
  

$$I_{22}(z) = \frac{2c \, \text{sh} \, \alpha_0}{\pi d^3} \sum_{k=0}^\infty (2k+1) P_k(\text{ch} \, \alpha_0) T_k H_k(z),$$
  

$$H_k(z) = \int_0^\infty Z_2(t) \, j_k(\tau t) \, t \, W_k(z,t) \, dt,$$

Журнал технической физики, 2003, том 73, вып. 8

$$W_k(t,z) = \begin{cases} \left(-1\right)^{\frac{3k+2}{2}} \sin\left(\frac{z}{d}t\right), & k - \text{ четное,} \\ \left(-1\right)^{\frac{3k+2}{2}} \cos\left(\frac{z}{d}t\right), & k - \text{ нечетное.} \end{cases}$$

Согласно представлению (10),

$$\mathbf{E}_{2}^{(1)}(M_{0}) = -\frac{1}{c\sqrt{\operatorname{sh}^{2}\alpha + \operatorname{sin}^{2}\beta}} \left[ \frac{\partial U_{2}^{(1)}}{\partial \alpha} \mathbf{e}_{\alpha} + \frac{\partial U_{2}^{(1)}}{\partial \beta} \mathbf{e}_{\beta} \right]$$

где

$$\frac{\partial U_2^{(1)}}{\partial \alpha} = \frac{U_0 \,\mathrm{sh}\,\alpha}{d} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y_n}{Q_n(\mathrm{ch}\,\alpha_0)} \frac{d}{d\xi} \,Q_n(\xi) \Big|_{\xi=\mathrm{ch}\,\alpha} P_n(\cos\beta),$$
$$\frac{\partial U_2^{(1)}}{\partial \beta} = -\frac{U_0}{d} \sin\beta \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y_n}{Q_n(\mathrm{ch}\,\alpha_0)} \times Q_n(\mathrm{ch}\,\alpha) \frac{d}{d\xi} \,P_n(\xi) \Big|_{\xi=\mathrm{cos}\,\beta}.$$

Если точка находится на ос<br/>иOz, то  $|z|>b, \beta=0$ или  $\beta=\pi,$ поэтому

$$\mathbf{E}_{2}^{(1)}(0,z) = \begin{cases} \mathbf{E}_{2}^{(1+)}(0,z) = -\frac{1}{c \, \mathrm{sh} \, \alpha} \frac{\partial U_{2}^{(1)}}{\partial \alpha} \, \mathbf{e}_{z}, \\ & \text{если } z > b, \beta = 0, \\ \mathbf{E}_{2}^{(1-)}(0,z) = \frac{1}{c \, \mathrm{sh} \, \alpha} \frac{\partial U_{2}^{(1)}}{\partial \alpha} \, \mathbf{e}_{z}, \\ & \text{если } z < -b, \beta = \pi, \end{cases}$$

где

$$\begin{split} \mathbf{E}_{2}^{(1+)}(\mathbf{0},z) &= -U_{0} \frac{\operatorname{sh}\alpha_{0}}{cd} \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1) \\ &\times P_{n}(\operatorname{ch}\alpha_{0})T_{n} \frac{d}{d\xi} Q_{n}(\xi) \Big|_{\xi=\frac{\varepsilon}{c}} \mathbf{e}_{z}, \\ \mathbf{E}_{2}^{(1-)}(\mathbf{0},z) &= U_{0} \frac{\operatorname{sh}\alpha_{0}}{cd} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n} (2n+1) \\ &\times P_{n}(\operatorname{ch}\alpha_{0})T_{n} \frac{d}{d\xi} Q_{n}(\xi) \Big|_{\xi=\frac{\varepsilon}{c}} \mathbf{e}_{z}, \end{split}$$

Коэффициент экранирования (ослабления) поля в точке  $M_0(0, z)$ , расположенной на оси Oz в области  $D_2$ , вычисляем по формуле

$$K_2^{(\pm)}(z) = \frac{\left|\mathbf{E}_2^{(1\pm)}(0,z) + \mathbf{E}_2^{(2)}(0,z)\right|}{\mathbf{E}_d(0,z)}.$$
 (32)

Напряженность вторичного поля в произвольной точке  $M_0$  на оси  $O_z$  области  $D_1$  равна

$$egin{aligned} & \mathbf{E}_1^{(+)}(0,z) = -rac{1}{c\, \mathrm{sh}\, lpha}\,rac{\partial U_1}{\partial lpha}\,\mathbf{e}_z, \ & \mathbf{e}$$
сли  $0\leq z\,< b, eta=0, \end{aligned}$ 

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_1(0,z) &= \left\{ \mathbf{E}_1^{(-)}(0,z) = \frac{1}{c\,\mathrm{sh}\,\alpha}\,\frac{\partial U_1}{\partial\alpha}\,\mathbf{e}_z, \\ &\quad \mathrm{если} \, -b < z \leq 0, \beta = \pi, \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

где

$$\mathbf{E}_{1}^{(+)}(0,z) = -\frac{U_{0}}{cd} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\tilde{y}}{P_{n}(ch\,\alpha_{0})} \frac{d}{d\xi} P_{n}(\xi) \Big|_{\xi=\frac{z}{c}} \mathbf{e}_{z},$$
$$\mathbf{E}_{1}^{(-)}(0,z) = \frac{U_{0}}{cd} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n} \frac{\tilde{y}}{P_{n}(ch\,\alpha_{0})} \frac{d}{d\xi} P_{n}(\xi) \Big|_{\xi=\frac{z}{c}} \mathbf{e}_{z}.$$

Согласно представлениям (15), (17), (18), (20), (23), следует, что

$$\begin{aligned} \frac{\tilde{y}}{P_n(\operatorname{ch}\alpha_0)} &= (2n+1)\operatorname{sh}\alpha_0 Q_n(\operatorname{ch}\alpha_0)T_n \\ &+ (2n+1)J_n + \frac{\operatorname{sh}\alpha_0}{\pi}\left(2n+1\right) \\ &\times \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k i^{n+k}(2k+1)P_k(\operatorname{ch}\alpha_0)T_k I_{nk}. \end{aligned}$$

Коэффициент экранирования (ослабления) поля в точке  $M_0(0, z)$ , расположенной на оси Oz в области  $D_1$ , вычисляем по формуле

$$K_{1}^{(+)}(z) = \frac{\left|\mathbf{E}_{1}^{(\pm)}(\mathbf{0}, z)\right|}{\left|\mathbf{E}_{d}(\mathbf{0}, z)\right|}.$$
(33)

### Вычислительный эксперимент

С помощью математической системы MathCAD 2000 [10] проведены вычисления коэффициента экранирования  $K_1^+(z)$  в области  $D_1$  для различных геометрических параметров экранов и материала

Отношение <u><i>z</i></u>	Значение угла раствора Θ <sub>0</sub> незамкнутой эллипсоидальной оболочки в градусах		
b	60	90	120
$\frac{2}{15}$	$\frac{0.956}{0.016}$	$\frac{0.943}{0.0078}$	$\frac{0.551}{0.00045}$
$\frac{3}{15}$	$\frac{0.695}{0.011}$	$\frac{0.694}{0.0047}$	$\frac{0.291}{0.00041}$
$\frac{4}{15}$	$\frac{0.429}{0.0089}$	$\frac{0.421}{0.0031}$	$\frac{0.173}{0.00039}$
$\frac{1}{3}$	$\frac{0.284}{0.0073}$	$\frac{0.274}{0.0021}$	$\frac{0.112}{0.00038}$
$\frac{7}{15}$	$\frac{0.137}{0.0051}$	$\frac{0.131}{0.0011}$	$\frac{0.05}{0.00037}$
$\frac{3}{5}$	$\frac{0.069}{0.0034}$	$\frac{0.067}{0.00056}$	$\frac{0.024}{0.00036}$
$\frac{11}{15}$	$\frac{0.039}{0.0021}$	$\frac{0.037}{0.00039}$	$\frac{0.013}{0.00035}$
$\frac{13}{15}$	$\frac{0.018}{0.00094}$	$\frac{0.016}{0.00028}$	$\frac{0.008}{0.00024}$

тонкостенной оболочки Г по формуле (33). Бесконечные суммы (25), (27) вычислялись с точностью  $10^{-6}$ . Бесконечная СЛАУ (24) решалась методом усечения [11] с точностью  $10^{-5}$ . Расчеты проведены для случаев, когда тонкостенная оболочка Г выполнена из органического стекла ( $\varepsilon_r = 3.7$ ,  $\gamma = 10^{-12} \,\Omega^{-1} \cdot m^{-1}$ ) [12] и материала типа PPV ( $\varepsilon_r = 5$ ,  $\gamma = 0.1 \,\Omega^{-1} \cdot m^{-1}$ ),  $\varepsilon = \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0$ ,  $\varepsilon_0 = (1/36\pi) \, 10^{-9} \, \mathrm{F} \cdot \mathrm{m}^{-1}$ ,  $\mu = \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \, \mathrm{H} \cdot \mathrm{m}^{-1}$ .

В таблице приведены значения коэффициента экранирования  $K^{(+)}(z)$  в зависимости от угла раствора  $\Theta_0$ незамкнутой эллипсоидальной оболочки *S* и месторасположения точки  $M_0(0, z)$  при b/a = 1.5, d/b = 2, d/l = 0.6,  $\Delta = 0.01d$ , V = 0,  $z_0 = 0$ , f = 50 Hz. В каждой строке таблицы верхние значения соответствуют органическому стеклу, нижние — материалу типа PPV.

На основании вычислительного эксперимента можно сделать следующие выводы.

1. Если тонкостенная цилиндрическая оболочка  $\Gamma$  выполнена из материала типа PPV, то коэффициент экранирования  $K_1^{(+)}(z)$  практически равен нулю для любого угла раствора  $\Theta_0$  эллипсоидальной оболочки *S*, т. е. поле не проникает в область  $D_1$ .

2. При увеличении угла раствора  $\Theta_0$  эллипсоидальной оболочки *S* коэффициент экранирования  $K_1^{(+)}(z)$  уменьшается.

3. При увеличении значения z коэффициент экранирования  $K^{(+)}(z)$  уменьшается для всех значений угла раствора  $\Theta_0$  эллипсоидальной оболочки S.

## Список литературы

- Жуков С.В. // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. 1983. № 5. С. 54–58.
- [2] Шпицберг В.Е. // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. 1989. № 1. С. 110–115.
- [3] Ерофеенко В.Т. Электромагнитные поля в экранирующих оболочках. Минск: Университетское изд-во, 1988. 246 с.
- [4] Аполлонский С.М., Ерофеенко В.Т. Эквивалентные граничные условия в электродинамике. СПб.: Безопасность, 1999. 416 с.
- [5] Лебедев Н.Н. Специальные функции и их приложения. М.; Л.: ГИТТЛ, 1953. 380 с.
- [6] Арсенин В.Я. Методы математической физики и специальные функции. М.: Наука, 1984. 384 с.
- [7] Справочник по специальным функциям с формулами, графиками и математическими таблицами / Под ред. М. Абрамовица, И. Стигана. М.: Наука, 1979. 840 с.
- [8] Уфлянд Я.С. Метод парных уравнений в задачах математической физики. Л.: Наука, 1977. 220 с.
- [9] Шушкевич Г.Ч. Расчет электростатических полей методом парных, тройных уравнений с использованием теорем сложения. Гродно: ГрГУ, 1999. 238 с.
- [10] Шушкевич Г.Ч., Шушкевич С.В. Введение в MathCAD 2000. Гродно: ГрГУ, 2001. 140 с.
- [11] Канторович Л.В., Крылов В.И. Приближенные методы высшего анализа. М.; Л.: Физматгиз, 1962. 708 с.
- [12] Енохович А.С. Справочник по физике. М.: Просвещение, 1990. 384 с.